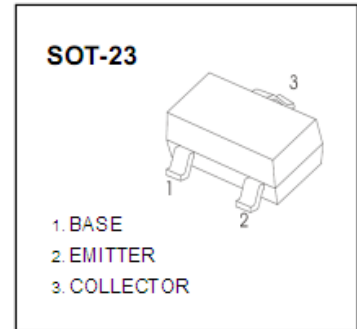


**MMBTH10 ( NPN )****印章/Marking : 3EM****特点/Features :**

VFH/UFH 晶体管;

**极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)**

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	$V_{CB0}$	30	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	$V_{CE0}$	25	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	$V_{EB0}$	3	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	$I_C$	0.05	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	$P_C$	0.225	W
热阻/Thermal Resistance From Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	556	°C/W
结温/Junction Temperature	$T_J$	150	°C
储存温度/Storage Temperature	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)**

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CB0)}$	$I_C=100 \mu A, I_E=0$	30			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CE0)}$	$I_C=1mA, I_B=0$	25			V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EB0)}$	$I_E=10 \mu A, I_C=0$	3			V
集电极截止电流	$I_{CB0}$	$V_{CB}=25V, I_E=0$			0.1	$\mu A$
发射极截止电流	$I_{EB0}$	$V_{EB}=2V, I_C=0$			0.1	$\mu A$
直流电流增益	$h_{FE}$	$V_{CE}=10V, I_C=4mA$	60			
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=4mA, I_B=0.4mA$			0.5	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE}$	$V_{CE}=10V, I_C=4mA$			0.95	V
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=10V, I_C=4mA, f=100MHz$	650			MHz
集电极输出电容	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$			0.7	pF